

Сведения об официальном оппоненте

По диссертации Ванькова Александра Борисовича на тему
«Оптическая спектроскопия сильнокоррелированных двумерных электронных систем в
квантующем магнитном поле»,
представленной к защите на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук по специальности 1.3.8 – «Физика конденсированного состояния».

Фамилия Имя Отчество	Глазов Михаил Михайлович
Год рождения, гражданство	1982, гражданин РФ
Учёная степень (отрасль наук)	Доктор физико-математических наук
Наименование специальности, по которой зашита диссертация	01.04.10 – физика полупроводников
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук
Должность	Ведущий научный сотрудник
Структурное подразделение	Сектор теории квантовых когерентных явлений в твердом теле
Почтовый адрес	194021, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.26
Официальный сайт	www.ioffe.ru
Электронная почта	glazov@coherent.ioffe.ru
Контактный телефон	+7 911 913 04 36

Список основных публикаций по тематике диссертации в рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет

Diffusion of Excitons in a Two-Dimensional Fermi Sea of Free Charges. Wagner K., Iakovlev Z.A., Ziegler J.D., Cuccu M., Taniguchi T., Watanabe K., <u>Glazov M.M.</u> , Chernikov A., Nano Lett. 2023, vol. 23, p. 4708
Coherent spin dynamics of excitons in strained monolayer semiconductors. Glazov M.M., Phys. Rev. B 2022 vol. 106, p. 235313
Valley and spin accumulation in ballistic and hydrodynamic channels, Glazov M. M., 2D Mater. 2022 vol. 9, p. 015027
Теория оптически детектируемых спиновых флуктуаций в наносистемах. Смирнов Д. С., Манцевич В. Н., <u>Глазов М. М.</u> , УФН 2021, т. 191, с. 973
Коллективные состояния экситонов в полупроводниках. <u>Глазов М.М.</u> , Сурис Р.А., УФН. 2020, т. 190, с. 1121
Optical properties of charged excitons in two-dimensional semiconductors. Glazov M.M., J. Chem. Phys. 2020, v. 153, p. 034703
Quantum Interference Effect on Exciton Transport in Monolayer Semiconductors. Glazov M.M., Phys. Rev. Lett. 2020 v.124, p.166802
Topological Spin Phases of Trapped Rydberg Excitons in Cu ₂ O. Poddubny A.N., Glazov M.M., Phys. Rev. Lett. 2019, v. 123, p. 126801

Intervalley polaron in atomically thin transition metal dichalcogenides. Glazov M.M., Semina M.A., Robert C., Urbaszek B., Amand T., Marie X. Phys. Rev. B 2019, v. 100, p. 041301(R)
Breakdown of the Static Approximation for Free Carrier Screening of Excitons in Monolayer Semiconductors. Glazov M.M., Chernikov A., Phys. Status Solidi B 2018, v. 255, p. 1800216

Ведущий научный сотрудник

Федерального государственного бюджетного учреждения

науки Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН

доктор физико-математических наук,

член-корреспондент РАН

Глазов Михаил Михайлович

Подпись Глазова Михаила Михайловича удостоверяю

Ученый секретарь

к. ф.-м.н.

М.И. Патров

« »

2023 г.



Печать организации